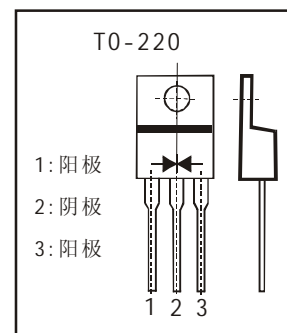


肖特基二极管—MBR10150CT

1、概述与特点

- 多层金-半硅势垒结构，多数载流子导电；
- 低功耗，高效率；
- 用于低压高频逆变电路，续流电路和保护电路；
- 带过压（箝）保护环；
- 封装型式：T0-220；
- 双管芯结构。



2、极限值

2.1 极限值：（除其他标注外 $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ）

参数	符号	数值	单位
最大反向重复峰值电压	VRRM	150	V
反向峰值工作电压	VRWM	150	V
最大直流阻断电压	VDC	150	V
$T_{amb} = 105^{\circ}\text{C}$ 整个器件最大正向平均整流电流	IF(AV)	10	A
正向峰值浪涌电流（额定负载 8.3ms 半正弦波—按 JEDEC 方法）	IFSM	100	A
反向重复峰值浪涌电流 $T_p = 2.0\mu\text{s}, 1\text{KHZ}$	IR	0.2	mA
最大结电容 0V, 1MHz	CJ (Max)	300	pF
工作结温	TJ	-65 ~ +175	$^{\circ}\text{C}$
储存温度范围	TSTG	-65 ~ +175	$^{\circ}\text{C}$

2.2、电性能（除其他标注外 $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ ）

参数	符号	数值	单位
最大正向瞬态峰值压降 双管芯单个器件 $T_F=5\text{A}, T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$	VF	0.8	V
最大反向瞬态电流 $T_{amb}= 25^{\circ}\text{C}$	IR	0.2	mA

3、特性曲线

